

Corporate Profile

技術と対話で未来をつくる

Technology & Tai-wa for Tomorrow

KOKUSAI ELECTRIC Way

私たちは、技術を常に追求します。

さまざまな領域で技術を磨き、それらを融合することにより、イノベーションを生み出します。

私たちは、対話を常に大切にします。

誠実に対話を続け、課題の本質と真摯に向き合うことにより、最良の解決策を導き出します。

私たちは、技術と対話で多様なニーズにお応えし、創造と革新が生まれる未来を支え続けます。

私たちの技術

- 技術を洗練する
- 技術を創出する
- 技術で挑戦する
- 技術で魅了する

Purpose
私たちの使命

技術と対話で未来をつくる

KOKUSAI ELECTRICグループは、
技術と対話で創造と革新が生まれる未来を支えます。

Vision
私たちのめざす姿

夢を未来につなぐベストパートナー

Value / Mission
私たちの価値観/行動

私たちの対話

- 先端技術との対話
- 自然環境との対話
- 社会課題との対話
- 自分自身との対話

マテリアリティ

成膜における技術的優位性を維持、強化し、 半導体デバイスの進化を支えていく

技術と対話でお客様と社会に貢献することが私たちの使命

当社グループは、半導体デバイス製造の前工程における成膜に特化した、半導体製造装置専門のグローバルメーカーです。当社グループが柱とする技術の一つはバッチALD^{※1}技術です。難易度の高い複雑な構造での高品質な成膜と高い生産性を両立させ、バッチALD対応成膜装置では2023年の世界シェア1位^{※2}を誇っています。もう一つの柱となるのが、独自のプラズマ処理が生み出す潤沢なラジカルによって等方性とステップカバレッジに優れた膜質改善を高い生産性で実現するトリートメント（膜質改善）技術です。トリートメントプロセス装置では2023年の世界シェア3位^{※3}となっています。

当社グループが半導体製造装置の開発に着手したのは、1950年代でした。以来、70年以上にわたって研究開発に取り組み、1980年代には、自然酸化膜混入防止と面内均一性の改善、パーティクル^{※4}の発生を大きく低減させる縦型成膜装置を世界に先駆けて開発しました。さらに1990年代には、ALD技術を確立、バッチ成膜技術とALD技術を組み合わせたバッチALD技術は、半導体デバイス構造の微細化、多層化、複雑化、三次元化に不可欠な技術であるとの高い評価をいただき、半導体デバイスの進化に寄与するとともに、当社グループの事業も大きく拡大しました。そして、お客様と対話を重ね、いかに均一な膜を生産性高く作るかを追求し、成膜に関する技術を改良、進歩させてきました。

技術の革新によって半導体デバイスの進歩を支え、お客様と社会に貢献していく。それが私たちの使命です。これまでの歴史は、その使命を果たすための歩みであり、これからもその使命を忘れてはならないと思っています。

「技術」と「対話」で価値を創造し、「成膜」を通じて世の中のお役に立てるよう全力で取り組んでいきますので、引き続き皆様のご理解、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※1 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

※2 TechInsights Inc. “TL_ALD Tools - Batch_YEARLY_v24.04” 2024 (April)

※3 Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2023, Bob Johnson, Gaurav Gupta, Menglin Cao, 1, May 2024
トリートメントプロセス装置 : RTP and Oxidation/Diffusion

GARTNER は、Gartner Inc. または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartner は、Gartner リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartner リサーチの発行物は、Gartner リサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartner は、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ（以下「Gartnerコンテンツ」）は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.（以下「Gartner」）が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

※4 半導体デバイスの製造プロセスにおいて悪影響を及ぼす主に数百～数十nmレベルの微粒子

代表取締役 社長執行役員

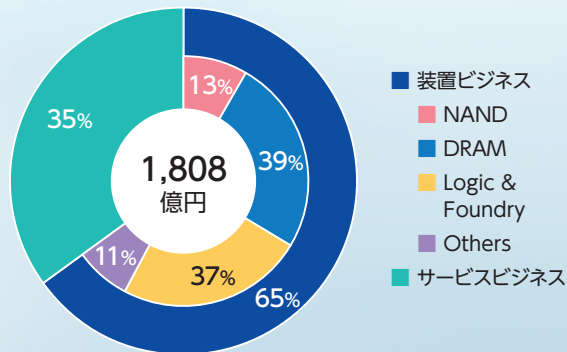
金井 史幸

At a Glance

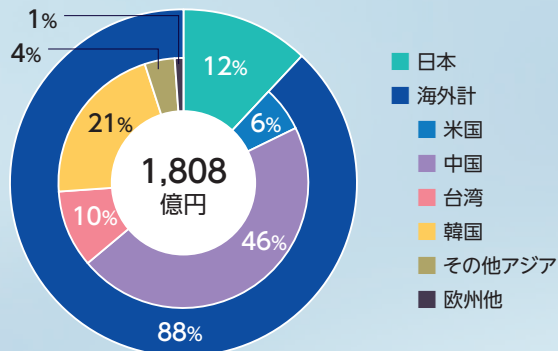
「成膜」に特化し、装置ビジネスでは世界トップクラスのマーケットシェアを有するバッチALD対応装置やトリートメント(膜質改善)プロセス装置が主力製品。

財務概要

2024年3月期ビジネス／アプリケーション別売上収益(連結)



2024年3月期地域別売上収益(連結)



※1 出典:TechInsights Inc. "TI_ALD Tools - Batch_YEARLY_v24.04" 2024 (April)

※2 出典:Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2023, Bob Johnson, Gaurav Gupta, Menglin Cao, 1, May 2024

トリートメントプロセス装置: RTP and Oxidation/Diffusion

GARTNERは、Gartner Inc. または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartner は、Gartner リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartner リサーチの発行物は、Gartner リサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartner は、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ (以下「Gartnerコンテンツ」) は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

事業内容

装置ビジネス (65%)

バッチ成膜装置

世界シェア No.1 (2023年)^{※1}

バッチALD

■数十枚以上のウェーハを一括処理するバッチ成膜装置のうちALD技術に対応可能な装置。デバイスの複雑化に伴い、高難易度成膜と高生産性が求められるようになり、ニーズが拡大。

■ALD:Atomic Layer Depositionの略称。当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

■LP-CVD、酸化技術、アニール(低温、高温)技術、拡散技術に対応した成膜プロセス装置

■CVD:Chemical Vapor Depositionの略称。ガスを同時に供給し、気相で化学反応を起こして成膜する手法。当社グループでは、LP-CVD:Low Pressure CVDに集中。



バッチCVD
ほか

トリートメントプロセス装置

世界シェア

No.3 (2023年)^{※2}

■成膜後にプラズマや加熱により膜中の不純物を除去し、粒子を安定させることで、膜質を改善させることを目的とした装置。

■デバイスの複雑化に伴い、等方性と優れたステップカバレージが求められ、ニーズが拡大。低温環境における膜質改善のニーズが拡大。



サービスビジネス (35%)

■当社グループが製造・販売する半導体製造装置のアフターサービス(部品販売、保守サービス、有償修理、装置の移設・改造、ウェーハサイズ200mm以下のレガシー装置販売など)。

■部品販売・保守サービスでは、2017年3月期から2023年3月期にかけてインストールベースで前期比10%以上の着実な成長を達成。

■“Design for Service Business”のコンセプトでさらなる高付加価値サービスの提供をめざす。



グローバルネットワーク

国内

2社

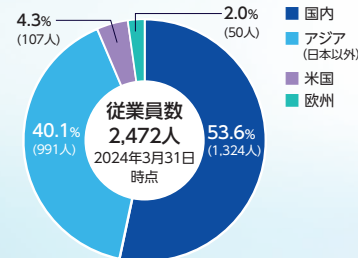
海外

6社

海外従業員数(連結)※

46.4%

地域別従業員割合 (連結)※



※ 2024年3月31日時点の当社従業員数は2,472人です。

そのうち、海外従業員数は46.4%となっています。

※ 従業員の重要な変動は発生していません。

国内拠点

海外拠点



Kokusai Electric Korea Co., Ltd.(Kook Je Electric Korea Co., Ltd.) : ●●○
 Head Office, Main Factory
 Pyeongtaek Factory

KE Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. : ○○
 Head Office

Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd. : ○○
 Head Office

Kokusai Semiconductor Singapore Pte. Ltd. ○○
 Head Office

Kokusai Semiconductor Equipment Corporation : ○○
 Head Office

Kokusai Semiconductor Europe GmbH : ○○
 Head Office

主な開発、設計、生産拠点

富山事業所

立山連峰を望む富山市八尾町。専用のクリーンルーム内で次世代プロセスに対応した半導体製造装置等の開発、設計、生産を行い、世界の大手ユーザーからの最先端の高度な製品ニーズに対応しています。



砺波事業所

2024年9月に竣工した新たな生産拠点。IoT、DX、生成AIなどの先端ソリューションを導入することでスマートファクトリー化を推進。富山県砺波市に位置し、既存の富山事業所にも近く、サプライチェーンやエンジニアの共通化も効率的に行えます。



株式会社国際電気セミコンダクターサービス 上市事業所

北アルプス絶岳の麓に位置し自然環境に恵まれた富山県上市町で、超音波洗浄機、抵抗率測定器の開発、設計、生産および半導体製造装置向けコントローラーの生産を行い、世界のユーザーへ製品を供給しています。



Kokusai Electric Korea Co., Ltd. 天安本社・工場

韓国の首都ソウルから南に約100kmの距離にある忠清南道天安市に位置し、半導体製造装置の設計、生産、改造を行って韓国のユーザーを中心に製品を供給しています。



Kokusai Electric Korea Co., Ltd. 平澤工場

韓国の首都ソウルの南に位置した京畿道平澤市。韓国ユーザーのサービス拠点として、また、半導体製造装置の評価開発を行い、地産地消を生かし、高度な技術と製品ニーズに対応しています。



中期経営計画

当社グループは、予想される市場環境やお客様ニーズの変化に適切に対応し、さらなる高収益体質へと転換するための施策を推進するため、中長期的な事業戦略および中期事業目標を策定しています。

なお、当社グループの経営方針、経営戦略については、当社ウェブサイトをご参照ください。

Ⅰ 事業環境の展望

半導体デバイスの市場規模は、2010年の約3,000億ドルに対し、12年後の2022年には約6,100億ドルと2倍以上に拡大しており、2023年から2028年まで年平均成長率9.5%で成長することが予想されています*1。半導体デバイス市場拡大の背景には、スマートフォンやパソコン等の電子機器の需要拡大や、AI、IoT、DX等の拡がりによるデータセンターの拡充、環境負荷低減への投資（GX）等の産業向けの需要拡大、主要国による産業支援策があります。足元の世界経済は、不透明な経済環境を受けてスマートフォンやパソコン等の電子機器の需要が引き続き低調に推移し、NANDを中心に半導体デバイスメーカーの投資抑制が続いています。しかし、半導体デバイス市場では在庫調整が進んでおり、メモリーデバイス単価の上昇が見られ始めたことから、2023年前半に市況が底を打ったとの見方をしています。2024年後半から2025年にかけて、半導体デバイスの需要が本格回復し、2027年に向けて技術革新の継続・加速により再び成長基調へ進んでいくものと期待しています*2。

半導体製造装置市場は2010年の約300億ドルに対し、12年後の2022年には約980億ドルと3倍以上に拡大しており、2023年から2028年まで年平均成長率7.5%で成長することが予想されています*2。足元では不透明な経済環境を受けて、NANDを中心に半導体デバイスメーカーの投資抑制が続いていますが、半導体デバイスの需要回復に伴って半導体製造装置の需要も回復するものと見えています。中長期的には、半導体デバイスの微細化、構造の複雑化、三次元化が進む中で、難易度の高い成膜と高い生産性を両立することのできる半導体製造装置へのニーズが高まると考えています。

※1 出典:TechInsights Inc. Semiconductor Forecast (March 24)

※2 出典:TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2018 - 2028) (March 2024)

半導体デバイス／半導体製造装置の世界市場規模(単位:十億ドル)

	2010年	2022年	2023年	2028年(予想)
半導体デバイスの世界市場規模	296.7	613.9	559.1	878.7
半導体製造装置の世界市場規模	30.4	97.7	99.0	142.3

出典:TechInsights Inc. Semiconductor Forecast (March 2024)

出典:TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2018 - 2028) (March 2024)

Ⅰ 中長期的な経営方針

当社グループは、半導体製造プロセスの前工程における「成膜」工程に注力しており、バッチ成膜装置、トリートメント（膜質改善）プロセス装置で世界トップクラスのシェアを有しています。近年、半導体デバイスの微細化や構造の複雑化、三次元化によってウェーハの表面が複雑な形状になり、高品質な薄膜等を形成するにはより高度な技術が必要とされています。これに対して当社グループは、難易度の高い成膜と高い生産性を両立するバッチ成膜技術や、高い生産性を維持しつつ形成された薄膜の膜質を改善するトリートメント技術を生かした高付加価値製品の販売拡大や研究開発に注力し、事業拡大を図っていきます。

また、装置のライフサイクル全体にわたって、メンテナンスや修理、部品供給、移設・改造などお客様のニーズに合わせたサービスの拡充を図るとともに、今後の需要拡大に対応するための生産体制および開発体制の拡充、DXを活用した生産効率向上にも注力していきます。

ESGの取り組みでは、①創造と革新による社会への貢献、②持続可能な社会の創造・地球環境の保全、③イノベーション創出の源泉となる人財マネジメント、④サステナビリティ経営の実現に向けたガバナンス体制の強化、⑤人権の尊重・配慮の5つのマテリアリティに基づき、課題解決に向けた活動を推進していきます。

Ⅰ 具体的な施策

- ① 高付加価値な技術・製品の継続的な創出、10年先を見据えた研究開発
- ② 売上・利益のさらなる拡大のための提案力とお客様エンゲージメント強化
- ③ 富山県砺波市における事業所の立ち上げと、新生産方式による生産能力の倍増化
- ④ サービスビジネスのさらなる拡大
- ⑤ グループ一体化経営による事業活動改革の継続
- ⑥ 収益率向上に向けたグループ横断での業務効率向上のさらなる推進
- ⑦ サステナビリティ経営の高度化推進

※詳細は有価証券報告書をご参照ください。

I 中期的な事業戦略

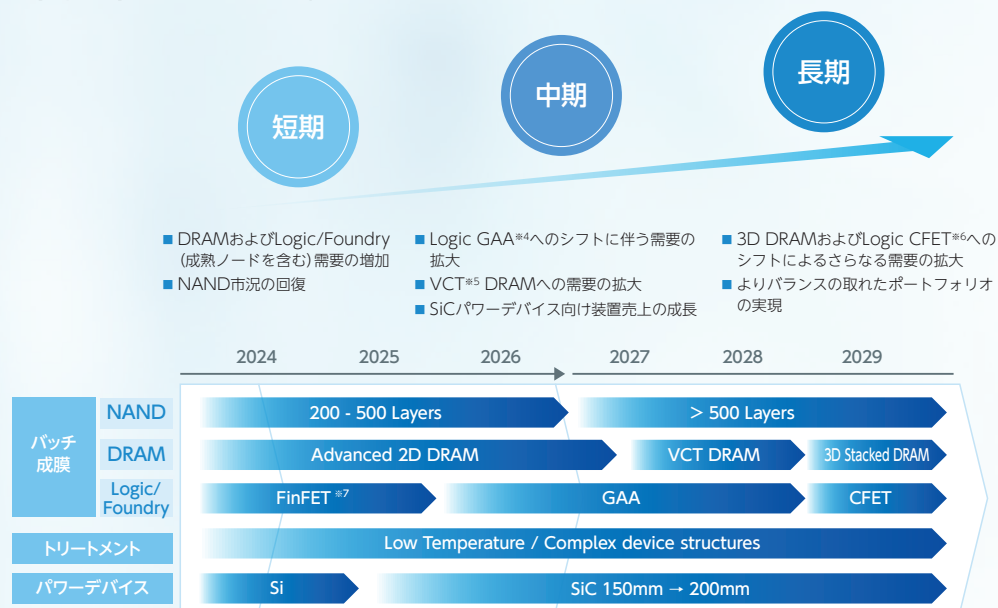
3つの戦略に重点的に取り組むことでWFE^{※1}を上回る事業成長の実現をめざします。

- 1 NAND、DRAM、Logic/Foundryの各アプリケーションの複雑化・三次元化に合わせて、当社のバッチALD^{※2}対応装置、トリートメントプロセス装置の販売を拡大
- 2 成熟ノード向けのバッチ成膜装置や成長著しいSiCパワーデバイス向け装置の販売推進による「成膜」領域での収益基盤の拡大
- 3 製品のライフサイクル全体でお客様のニーズに対応するサービスを提供し、高収益なサービスビジネスの事業拡大

※1 Wafer Fab Equipmentの略

※2 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

短期・中長期のカタリスト^{※3}当社グループのロードマップ



※3 当社推定 ※4 Gate All Around ※5 Vertical Channel Transistorの略 ※6 Complimentary Field Effect Transistor
※7 Fin Field-Effect Transistor

I 中期事業目標

当社グループは、WFEが1,200億ドル以上に拡大することを前提として、3～4年での達成をめざす中期事業目標を設定しています。具体的には、売上収益3,300億円以上、調整後営業利益率30%以上をめざしています。ビジネス別売上構成は装置ビジネスが75%程度、サービスビジネスが25%程度、また、装置売上のアプリケーション別売上構成はLogic/Foundry、その他で50%、DRAMとNANDを合わせたメモリーで50%を想定しています。設備投資は従来の年間20～30億円から年間40～60億円に増加し、半導体デバイスの進化に対応するため、売上収益の6%以上に相当する研究開発費を毎年投じていきます。

また、当社グループでは、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応として、中長期的な視点で資本収益性を向上させるため、WACC (Weighted Average Cost of Capital:加重平均資本コスト) を上回るROIC (Return on Invested Capital:投下資本利益率) およびROE (Return on Equity:自己資本利益率) の目標を設定しています。ディスクロージャーポリシーに則り、ステークホルダーの皆様と積極的に対話を行ってまいります。

	2024年3月期実績	中期目標
売上収益	1,808億円	3,300億円以上
装置ビジネス売上比率	65%	75%程度
サービスビジネス売上比率	35%	25%程度
調整後営業利益率	20.9%	30%以上
研究開発費 (対売上収益比率)	7.0%	6%以上
(参考) ROE (自己資本利益率)	15.7%	25%以上
(参考) ROIC (投下資本利益率)	10.1%	23%以上
(参考) 前提としたWFE市場規模	\$100Bil (2023年)	\$120Bil以上

I 株主還元の強化

- ① 国内外の同業他社と同水準の連結配当性向20～30%
- ② ネットキャッシュ^{※8}達成後、有利子負債分割償還後フリー・キャッシュ・フロー^{※9}の70%程度に相当する金額を機動的な自己株式取得および配当に充当することをめざす
- ③ 配当と自己株式取得を合わせた総還元性向は、中期事業目標達成時に約50%を見込む

※8 ネットキャッシュ＝現金及び現金同等物－有利子負債

※9 有利子負債分割償還後フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー－有利子負債の分割償還額

当社グループのCSR・サステナビリティ経営の考え方

当社グループは、事業活動を通じて社会の信頼・期待に応えていくことが企業の社会的責任であると考えています。

私たちのサステナビリティ経営は、この社会的責任を強く自覚した上で、事業活動とESG(環境・社会課題の解決、ガバナンスの強化)の両側面から経済価値および環境・社会価値を追求することにより、SDGsの達成に寄与するとともに、持続可能な社会の実現と当社グループの持続的な発展の両立をめざすものです。

当社グループでは、企業理念、マテリアリティ(重要取り組み課題)、専門会議体の運営、国際的イニシアティブへの参画などの活動基盤により、サステナビリティ経営を推進しています。

これらの活動の実践状況は、本報告書やウェブサイトなどで公表し、ステークホルダーの皆様と当社グループのサステナビリティ経営について広く対話する材料とします。

SDGsの達成に寄与・持続可能な社会の実現



当社グループの持続的な発展



KOKUSAI ELECTRICグループの企業理念

当社グループは、KOKUSAI ELECTRIC Wayのもと、SDGs達成への貢献と当社グループの持続的な発展の両立をめざすため、重点的に取り組む課題としてマテリアリティを特定し、事業活動とESG(環境・社会課題の解決、ガバナンスの強化)の両側面から、持続可能な社会の実現と当社グループの持続的な発展の両立をめざしています。

KOKUSAI ELECTRIC Way< コーポレートスローガン >

技術と対話で未来をつくる / Technology & Tai-wa® for Tomorrow

— KOKUSAI ELECTRICグループは、技術と対話で創造と革新が生まれる未来を支えます —

マテリアリティ (重要取り組み課題)

中長期事業戦略/中期経営計画

年度運営方針

各部門の運営方針・業務予算、具体的なアクションアイテム/KPI

B (ビジネス) の側面

予算会議、事業戦略会議等で審議・フォローアップ

E/S/Gの側面

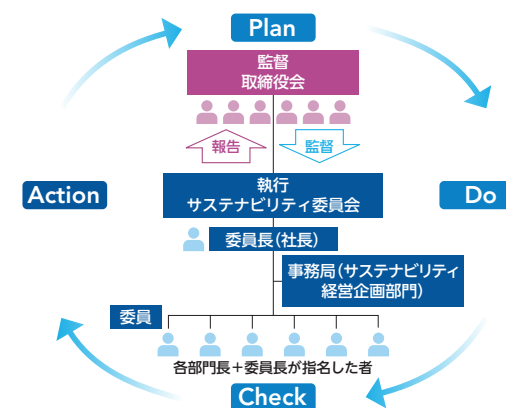
サステナビリティ委員会で審議・フォローアップ

サステナビリティ委員会

当社は、サステナビリティ活動を牽引する専門の会議体として、社長を委員長としたサステナビリティ委員会を設置・運営しています。

サステナビリティ委員会は、さまざまな社会課題、事業課題に対応するために必要な専門性をもった委員で構成しています。委員会の審議事項は、マテリアリティ、外部の要求事項等を考慮しながら決定しています。委員会を中心としたサステナビリティ活動の状況は、定期的に取り締役に報告し、社内に周知しています。

サステナビリティ活動の推進状況は、本報告書や当社ウェブサイトなどで公表し、ステークホルダーの皆様と広く当社の経営について対話する材料としていきます。



価値創造プロセス

当社グループは、サステナビリティ経営基盤[KOKUSAI ELECTRIC Wayの実現とESGの取り組み(環境・社会課題の解決、コーポレートガバナンスの強化)]のもと、解決すべきマテリアリティを起点に、経営資本を有効に活用した事業とESGの取り組みの両側面での活動を通じ、産業・社会の発展や持続可能な社会の構築に貢献していく価値創造プロセスを描き、その実現に向け高品質・高性能な製品および付加価値の高いサービスの提供、持続可能な社会の構築に努めていきます。



事業戦略

近年、半導体デバイス構造の複雑化、三次元化によってウェーハの表面が複雑な形状になり、高品質な薄膜を形成するにはより高度な成膜技術が必要とされています。また、複雑な形状での高品質な成膜には時間がかかるため、生産性の課題が顕在化しています。これに対して当社グループは、難易度の高い成膜と高い生産性を両立するバッチALD*技術や、高い生産性を維持しつつ形成された薄膜の膜質を改善するトリートメント技術を生かした高付加価値製品の販売拡大や研究開発に注力し、事業拡大を図っていきます。また、装置のライフサイクル全体にわたって、メンテナンスや修理、部品販売、移設・改造などお客様のニーズに合わせたアフターサービスの拡充を図るとともに、今後の需要拡大に対応するための生産体制および開発体制の拡充、DXを活用した生産効率向上にも注力していきます。

装置ビジネスの概要

成膜プロセス装置

成膜プロセス装置は、ウェーハの電子回路形成における回路素材となるポリシリコン膜や絶縁膜等の薄膜を形成する装置です。「ALD」「LP-CVD」「酸化」「拡散」「アニール」などに適応しています。この成膜工程は、ウェーハ上の回路形成において重要な役割を担うことから、各装置に高度な技術と信頼性の高い製品提供が不可欠となります。当社グループの主力製品であるバッチ成膜装置は、世界中の半導体デバイスメーカーから高く評価されており、中でもバッチALD対応装置は世界トップクラスのシェアを有しています。

ミニバッチ成膜プロセス装置「TSURUGI-C²® 剣®」

- 次世代対応に向けた成膜性能と高生産性を備えた装置
- 最新のバッチALD技術など薄膜形成プロセスに対応



ラージバッチ成膜プロセス装置「AdvancedAce®-II」

- 高難易度成膜に加えてラージバッチによる処理枚数の増加と処理時間の短縮を実現した装置
- バッチALD技術、バッチCVD技術、酸化技術、拡散技術、アニール技術などに対応



QUIXACE®-II

- 高品質な成膜性能と高生産性を備えた装置
- バッチALD技術、バッチCVD技術、酸化技術、拡散技術、アニール技術などに対応
- 豊富な納入実績を誇る当社ベストセラー製品



トリートメント(膜質改善)プロセス装置

トリートメントプロセス装置は、成膜後にプラズマや加熱により膜中の不純物の除去や粒子を安定させることで膜質を改善させることを目的とした装置です。当社グループで製造・販売しているトリートメントプロセス装置には、独自のプラズマ源を用いた酸窒化・トリートメントプロセス装置、ノンプラズマでヒーターを熱源としたアニール装置などがあります。特に「MARORA®」は複雑な半導体形状に対しても高い生産性と品質でのトリートメントが可能であり、半導体デバイスメーカーからの需要を集めています。

枚葉トリートメントプロセス装置「TANDUO®」

- 成膜後に加熱により膜質を改善させることを目的とした装置
- 低温でのアニールが可能



枚葉トリートメントプロセス装置「MARORA®」

- 成膜後にプラズマや加熱により膜質を改善させることを目的とした装置
- 複雑な半導体形状に対して、高い生産性と品質でのトリートメントが可能



VERTEX® Revolution

- 共通プラットフォームによる操作性の統一
- メンテナンス作業の一貫性
- スペアパーツの共通化による在庫コストの最適化
- WPS (Wafer Protection System) による高額なSiCウェーハのスクラップコスト低減

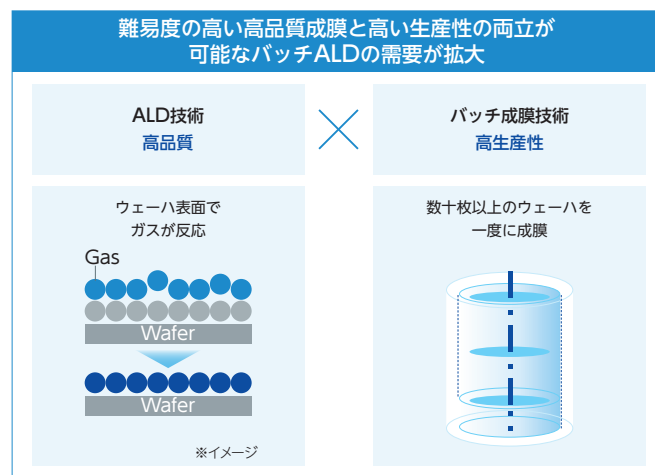
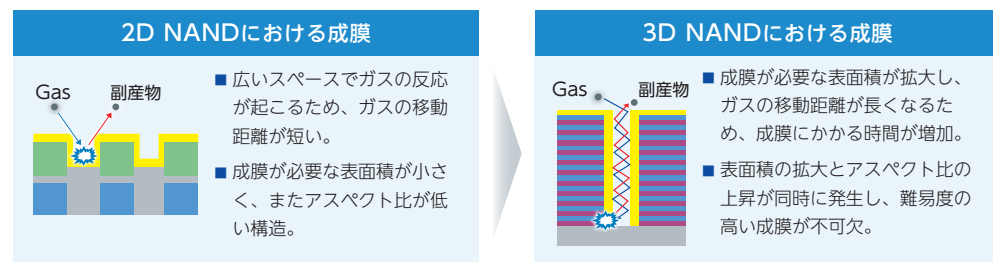


※ 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

当社グループの強み

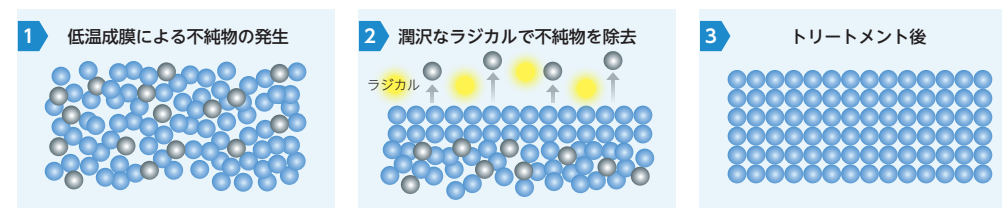
■ バッチALD^{※1}技術

ALD(Atomic Layer Deposition)技術は、高品質な薄膜をステップカバレッジ良く形成することが可能な難易度の高い成膜技術で、半導体デバイスの進化とともにニーズが高まっています。このALD技術は、複数のガスをサイクリックに供給し、成膜を行うため、成膜に時間がかかり生産性に課題がありました。これに対して、一度に数十枚以上のウェーハへの成膜を可能とするバッチ成膜技術の生産性の高さが有効な解決策となります。高品質な成膜を実現するALD技術と、数十枚以上のウェーハを一度に成膜するバッチ成膜技術を組み合わせた当社グループのバッチALD技術は、高生産性と高難易度な成膜を両立する論理的なソリューションです。



■ トリートメント(膜質改善)技術

トリートメント技術とは、成膜後にプラズマや熱を加えることにより膜中の不純物を除去し、粒子を安定させることで膜質を改善させる技術です。半導体デバイスの微細化・複雑化に伴い低温環境での成膜需要が高まっており、トリートメント技術は低温環境で膜質改善を可能にするソリューションとしても需要が拡大しています。当社グループのトリートメントプロセス装置は、独自のプラズマ方式が生み出す潤沢なラジカルにより、等方性とステップカバレッジに優れた膜質改善を、高い生産性で実現するソリューションです。



■ アプリケーション別の取り組み

3D NANDで先行した技術的優位性をDRAMやLogicに展開し、NAND、DRAM、Logic/Foundry向けのそれぞれのバランスのとれた成長をめざします。

Logic/Foundry	・GAA ^{※2} で新規開発POR ^{※3} を獲得済み。 ・GAA第2世代でTAM ^{※4} が拡大、さらなる新規POR獲得をめざす。 ・CFET ^{※5} でのバッチ成膜プロセス増加(FinFET ^{※6} 比1.4倍)に伴いシェア拡大をめざす。
DRAM	・先端DRAMの高難度成膜で新規PORを獲得済み。 ・デバイス進化でTAM拡大、さらなる新規POR獲得をめざす。 ・3D DRAMでのデバイス構造複雑化に伴い、3D NANDと同様にシェア拡大をめざす。
NAND	・ラージバッチ成膜プロセス装置＋ミニバッチ成膜プロセス装置により、3D NANDの成膜プロセスで圧倒的シェアを獲得済み。 ・市況回復とデバイスの多層化が進むにつれて需要拡大が期待される。

※1 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

※2 Gate All Aroundの略

※3 POR:Process of Recordの略で、顧客の半導体製造プロセスにおける製造装置認定を指す

※4 Total Addressable Marketの略

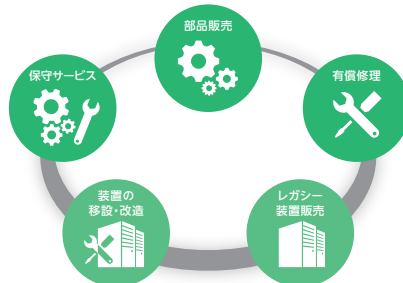
※5 Complementary Field Effect Transistorの略

※6 Fin Field-Effect Transistorの略

事業戦略

サービスビジネスの概要

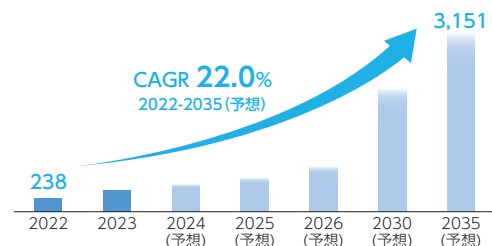
当社グループが製造・販売する半導体製造装置のメンテナンスや修理・部品販売、装置の移設・改造等のアフターサービスを提供しています。半導体生産工場では、半導体製造装置が年中無休で稼働しています。そのため、耐久性の高い製品はもちろん、製品のメンテナンスや修理・部品販売、装置の移設・改造等のアフターサービスを提供しています。また、ウェーハサイズ200mm以下の装置と中古装置の販売等も行っているほか、お客様に当社グループが製造した半導体製造装置を、最も効率良く、正しくご使用いただくため、装置のメンテナンスや操作方法をレクチャーするトレーニングセンターも設置しています。



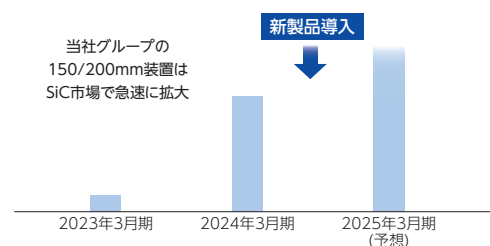
SiCパワーデバイス

SiCパワーデバイス市場では、高温活性化アニール装置へのニーズが拡大し、デバイスのウェーハサイズが150mmから200mmに移行するとともに需要拡大が期待されます。当社グループでは、SiCパワーデバイス高温活性化アニール新製品投入を進めながら、既存製品での売上伸長を見込んでいます。また、2026年3月期より、高温活性化アニール新製品での売上拡大を見込んでいます。

SiCパワーデバイスの市場動向（十億円）



SiC関連売上高



High-Temp Activation Anneal（新製品）

- 極めて高温にするための新たな加熱システムと150/200mmの共通プラットフォームを採用
- 2025年以降の量産開始を想定



Topics 砺波事業所について

富山県砺波市に新しい工場として砺波事業所を建設するとともに、富山事業所では、製造機能の一部を砺波事業所にシフトし、開発機能を拡充します。これらにより、2026年3月期の製造キャパシティは2021年3月期に比べて約2倍、開発キャパシティは1.5倍に拡大し、2031年3月期までの需要拡大に対応できる体制を構築します。

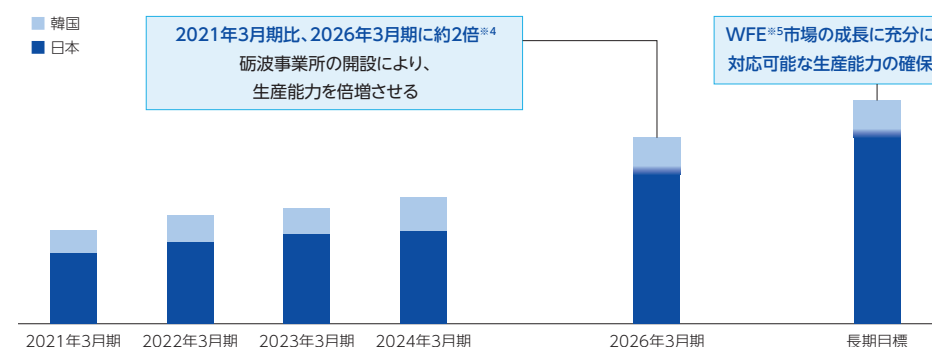
砺波事業所概要

名称	砺波事業所
所在地	富山県砺波市下中条
敷地面積	約40,000㎡
投資金額	約240億円
用途／建設目的	半導体製造装置の製造／生産能力の拡大と既存の富山事業所における研究開発体制の強化

砺波事業所SFX200^{※1}コンセプト



生産能力の増強



※1 SFX200はSmart Factory Transformationの略に各種取り組みで生産力を200%（2倍以上）に継続的に活動するプロジェクトのコンセプト名を指す

※2 SXはSmart Transformationの略でIoT/IT/デジタル化の先端技術とデータを活用したスマート生産・管理への変革活動を指す

※3 設備設置面積の一定単位当たりの生産能力を指す。ベンチマークは2021年3月期の富山工場の生産効率比

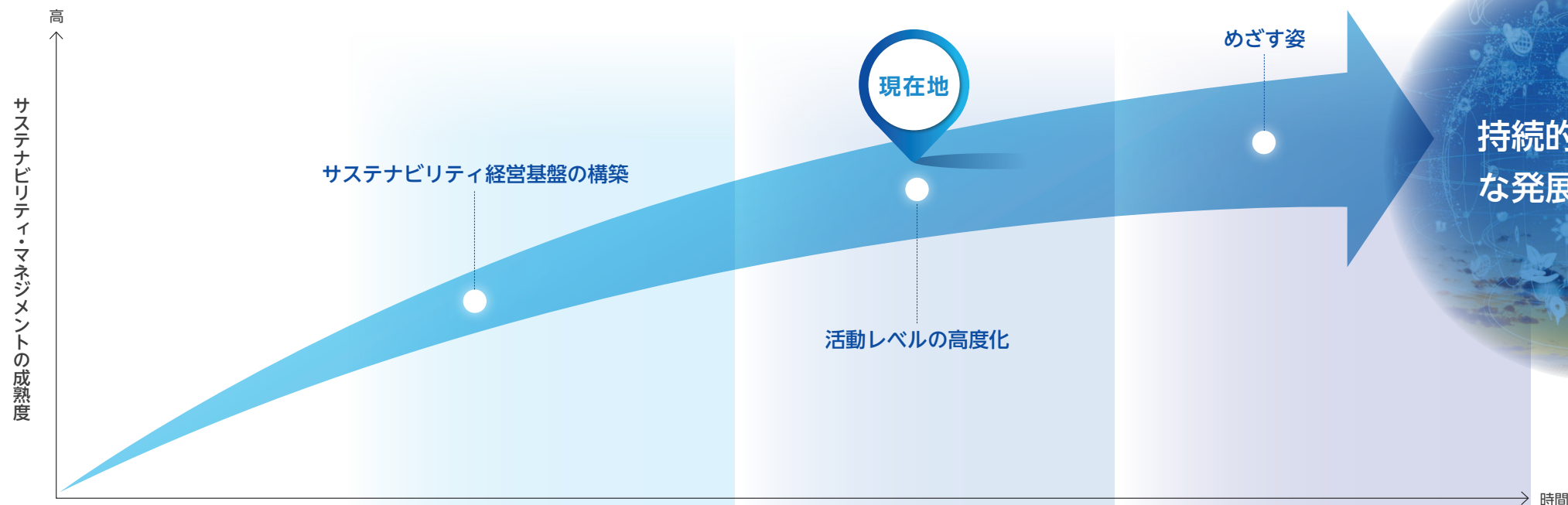
※4 当社投資計画

※5 Wafer Fab Equipmentの略で、半導体製造装置を指す

ESG戦略

環境・社会課題の解決に向けた取り組みの重要性や注目度が高まり続ける中、当社では、SDGsをはじめとする国内外の最新動向を踏まえ、実効的なコーポレート・ガバナンスと企業の持続可能な成長を実現するための「グローバル・サステナビリティ・ガバナンス」の構築に向け、めざす姿と中長期的なロードマップを描き、全社的な取り組みを推進しています。

各種の取り組みにおいては、共通して「KOKUSAI ELECTRICらしさ」を重視し、当社グループの強みや果たすべき使命に基づくサステナビリティ経営の実践、企業価値の向上をめざしています。



企業価値向上へのロードマップ

サステナビリティ戦略	コーポレートスローガン・パーパスの制定、マテリアリティ(重要取り組み課題)の特定	マテリアリティに対する取り組み、進捗確認、定期見直し	コーポレートスローガン・パーパスの具現化、マテリアリティKPIの達成
エンゲージメント戦略	各ステークホルダーとの“対話／Tai-wa”の促進、エンゲージメントポリシーの策定		各ステークホルダーとのエンゲージメント確立
サステナビリティ情報開示	ESG評価機関・情報開示ガイドライン等の外部期待値とのGap把握	ESG Indexへの組み入れ	ESG優良企業としての開示体制確立
	ウェブサイト、統合報告書、コーポレートガバナンス報告書、有価証券報告書等における情報開示の拡充		
サステナビリティ推進体制	グローバル・サステナビリティ・ガバナンス体制の構築・強化 (サステナビリティ委員会の設置・運用、グループ会社への活動浸透等)		サステナビリティ推進体制の確立

財務概況

4年間の主要財務データ

主要項目	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
売上収益(百万円)	178,023	245,425	245,721	180,838
売上総利益(百万円)	75,951	107,069	100,805	74,965
売上総利益率(%)	42.7	43.6	41.0	41.5
営業利益(百万円)	60,037	70,652	56,064	30,745
営業利益率(%)	33.7	28.8	22.8	17.0
税引前利益(百万円)	50,504	69,264	55,895	29,757
税引前利益率(%)	28.4	28.2	22.7	16.5
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円)	33,043	51,339	40,305	22,374
(参考) 調整後営業利益(百万円)	52,413	79,421	64,251	37,839
(参考) 調整後当期利益(百万円)	31,903	55,566	45,985	27,296
資本合計(百万円)	64,943	119,519	160,881	187,388
資産合計(百万円)	273,769	356,532	373,539	375,433
有利子負債(百万円)	125,760	123,191	99,206	93,018
ネット・キャッシュ(百万円)	△85,721	△14,792	6,847	△399
研究開発費(百万円)	7,552	9,885	12,425	12,683
設備投資額(百万円)	2,562	3,322	6,568	20,454
減価償却費および償却費(百万円)	9,609	10,004	10,304	10,945
営業キャッシュ・フロー(百万円)	51,127	73,615	29,993	2,942
投資キャッシュ・フロー(百万円)	△3,312	△3,348	△7,825	△11,950
財務キャッシュ・フロー(百万円)	△48,317	△3,508	△25,113	△6,312
フリー・キャッシュ・フロー(百万円)	47,815	70,267	22,168	△9,008
1株当たり親会社所有者帰属持分(円)	281.87	518.75	698.26	811.20
基本的1株当たり当期利益(円)	143.42	222.83	174.93	96.82
1株当たり配当金(円)	—	—	—	11.00
配当性向(%)	—	—	—	11.4
研究開発比率(%)	4.2	4.0	5.1	7.0
自己資本比率(%)	23.7	33.5	43.1	49.9
(参考) 自己資本利益率(ROE) (%)	47.3	60.2	32.8	15.7
(参考) 投下資本利益率(ROIC) (%)	17.1	25.6	18.3	10.1

※ 当社グループは国際会計基準 (IFRS) に基づいて連結財務諸表を作成しています。

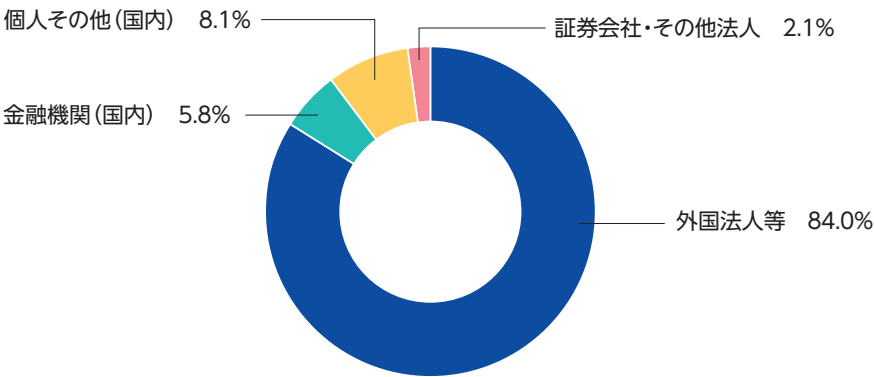
※ 1株当たり配当金および配当性向については、上場後のみを記載しています。2024年3月期の1株当たり配当金につきましては、上場時期が下半期であることを踏まえて半期分の金額としています。

会社情報／株式の状況

会社概要／株式関連情報 (2024年3月31日現在)

社名	株式会社KOKUSAI ELECTRIC
設立	2017年2月2日
本社所在地	〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地 oak 神田鍛冶町5階
資本金	112億62百万円
従業員数	連結:2,472人／単体:1,125人
上場市場	東京証券取引所 プライム市場
証券コード	6525
発行可能株式総数	900,000,000株
発行済株式総数	232,928,202株
事業年度	4月1日～翌年3月31日
定時株主総会	毎年6月
株主確定基準日	3月31日
期末配当金受領株主確定日	3月31日
中間配当金受領株主確定日	9月30日
単元株式数	100株

所有者別株式分布状況 (2024年3月31日現在)



大株主の状況 (2024年3月31日現在)

株主名	保有数(株)	持ち株比率(%)
KKR HKE Investment L.P.	101,025,800	43.37
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC	34,759,830	14.92
KSP Kokusai Investments, LLC	15,619,500	6.70
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	14,083,454	6.04
Qatar Holding LLC	11,520,000	4.94
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	9,803,300	4.20
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	2,051,000	0.88
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD	1,952,140	0.83
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT	1,506,900	0.64
CEPLUX THREADNEEDLE (LUX)	1,097,900	0.47

※ 当社は2024年7月10日付で開示しました「株式の売出しに関するお知らせ」のとおり、大株主であるKKR HKE Investment L.P.およびKSP Kokusai Investments, LLCが保有する当社普通株式の売出し（60,381,700株）を実施いたしました。その結果、現在の大株主の状況につきましては、上記2024年3月31日現在のものとは大きく異なっています。なお、株式の売出しに関する詳細につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。

技術と対話で未来をつくる

